



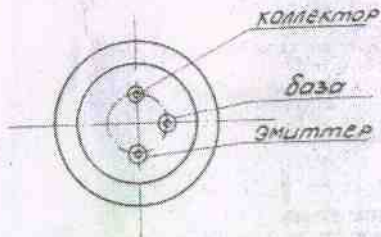
ТРАНЗИСТОРЫ
2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В,
2Т306Г

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарно-эпитаксиальные $n-p-n$ -транзисторы в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в переключающих (2Т306А, 2Т306Б) и усилительных (2Т306В, 2Т306Г) схемах.

Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
при $t = (25 \pm 10)^\circ \text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения, тип транзистора	Норма	
	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($I_K = 0, I_E = 10 \text{ мА}$)		
2Т306А	20	60
2Т306Б	40	120
2Т306В	20	100
2Т306Г	40	200
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ} = 15 \text{ В}$)	—	0.5
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ} = 4 \text{ В}$)	—	1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_E = 10 \text{ мА}, f = 10^7 \text{ Гц}$)		
2Т306А, 2Т306В	3	—
2Т306Б, 2Т306Г	5	—
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_K = 10 \text{ мА}, I_E = 1 \text{ мА}$)	—	0.3
2Т306А, 2Т306Б	—	—
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_K = 10 \text{ мА}, I_B = 1 \text{ мА}$)	—	1
2Т306А, 2Т306Б	—	—
Время рассасывания, нс ($I_{K1} = 10 \text{ мА}, I_{B1} = 1 \text{ мА}, I_{B2} = 1.2 \text{ мА}, R_K = 75 \text{ Ом}$)	—	30
2Т306А, 2Т306Б	—	—
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, нс ($U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_E = 5 \text{ мА}, f = 10^7 \text{ Гц}$)	—	500
2Т306В, 2Т306Г	—	—
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала, Ом ($U_{КБ} = 5 \text{ В}, I_E = 5 \text{ мА}, f = 10^7 \text{ Гц}$)	—	30
2Т306В, 2Т306Г	—	—
Граничное напряжение, В ($I_E = 1 \text{ мА}$)	10	—
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{КБ} = 5 \text{ В}, f = 10^7 \text{ Гц}$)	—	5
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{ЭБ} = 0, f = 10^7 \text{ Гц}$)	—	4.5

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ

золото — 12,7623 г.

в том числе:

золото — $0,8484 \cdot 10^{-4}$ г/мм на 3 выводах длиной 23 мм каждого транзистора.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов 2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г соответствуют техническим условиям 0.336.015 ТУ.

Приняты по извещению № 6 от 10.01.92.
дата

Место для проставки
конкретного типа транзисторов,
находящихся в данной упаковке

2Т306Б

Место для штампа
ОТК ОТК 51
1-92

Место для штампа
представителя
заказчика